(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年9月12日(12.09.2025)

WIPO | PCT

(10) 国際公開番号
WO 2025/187424 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/683 (2006.01) *C23C 16/458* (2006.01)

(21) 国際出願番号： PCT/JP2025/005655

(22) 国際出願日： 2025年2月19日(19.02.2025)

(25) 国際出願の言語： 日本語

(26) 国際公開の言語： 日本語

(30) 優先権データ：
特願 2024-032340 2024年3月4日(04.03.2024) JP

(71) 出願人: 東京エレクトロン株式会社(**TOKYO ELECTRON LIMITED**) [JP/JP]; 〒1076325 東京都港区赤坂五丁目３番１号 (JP).

(72) 発明者: 淺 原 玄 徳 (**ASAHARA Masanori**); 〒9813629 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ１番 東京エレクトロン宮城株式会社内 (JP). 矢口 徹磨(**YAGUCHI Tetsuma**); 〒1076325 東京都港区赤坂五丁目３番１号 東京エレクトロン株式会社内 (JP).

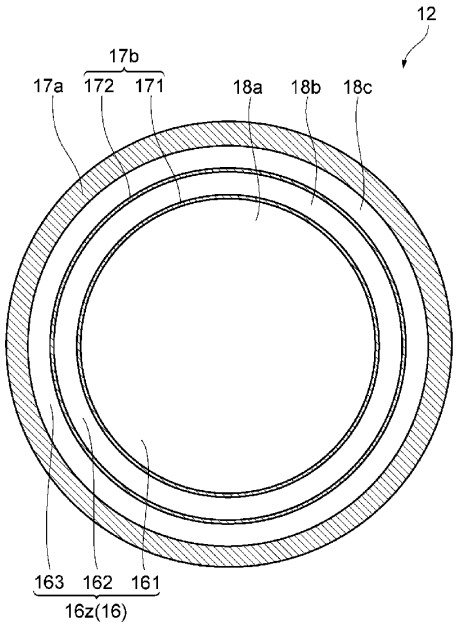
(74) 代理人: 長谷川 芳樹，外(**HASEGAWA Yoshiki** et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号 丸の内ＭＹ ＰＬＡＺＡ（明治安田生命ビル） ９階 創英国際特許法律事務所 (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UY, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU,

(54) **Title:** SUBSTRATE PROCESSING DEVICE

(54) 発明の名称： 基板処理装置



(57) **Abstract:** One exemplary embodiment of the present invention provides a substrate processing device. This substrate processing device includes a processing chamber, a substrate support table, a plurality of supply pipes, one or more recovery pipes, one or more flow rate regulators, and a control unit. The substrate support table includes an upper surface, a lower surface, and one or more partition walls. The one or more partition walls and the lower surface define one or more spaces. Each of the plurality of supply pipes has an opening end. The opening end is disposed in a corresponding space among the one or more spaces. The one or more recovery pipes are respectively connected to the one or more spaces. The one or more partition walls include an outer peripheral wall. The one or more spaces include one space in which the opening end of each of two or more supply pipes among the plurality of supply pipes is disposed.

WO 2025/187424 A1

［続葉有］

TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

一　国際調査報告（条約第21条(3)）

(57) 要約：一つの例示的実施形態において、基板処理装置が提供される。基板処理装置は、処理チャンバ、基板支持台、複数の供給管、一つ以上の回収管、一つ以上の流量調整器、及び制御部を備える。基板支持台は、上面、下面、一つ以上の隔壁を含む。一つ以上の隔壁と下面とは一つ以上の空間を画成する。複数の供給管は、それぞれ開口端を有する。開口端は、一つ以上の空間のうち対応する空間内に配置されている。一つ以上の回収管は、一つ以上の空間にそれぞれ接続されている。一つ以上の隔壁は、外周壁を含む。一つ以上の空間は、複数の供給管のうち二つ以上の供給管の各々の開口端がその中に配置された一つの空間を含む。